

ホール側壁ONO膜の構造観察

FIB法による特定箇所への平面TEM観察

測定法 : FIB・TEM
製品分野 : LSI・メモリ
分析目的 : 形状評価・故障解析・不良解析

概要

ナノオーダーでの加工が可能なFIB技術を用いることにより、特定箇所の平面TEM観察が可能です。これにより、断面からの観察では構造の確認が困難なホール側壁のキャパシタ絶縁膜のONO三層構造(シリコン酸化膜/シリコン窒化膜/シリコン酸化膜)が確認できます。

データ

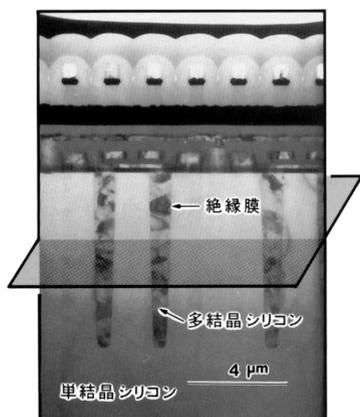


写真1 ホールキャパシタ断面TEM像

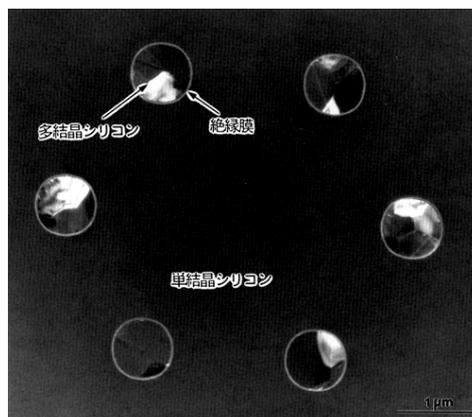


写真2 ホールキャパシタ平面TEM像(暗視野像)

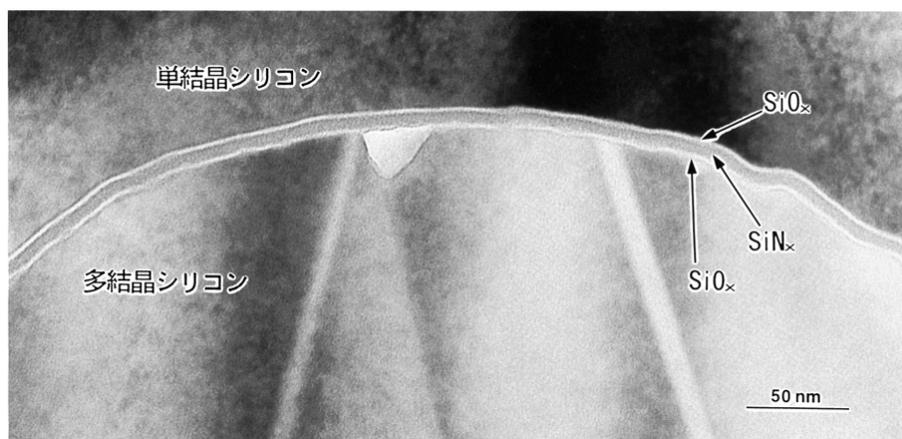


写真3 ホール側壁絶縁膜の高倍率TEM写真

分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！

一般財団法人
MST 材料科学技術振興財団

TEL : 03-3749-2525 E-mail : info@mst.or.jp
URL : <http://www.mst.or.jp/>